

性能特点

- 工作频段： 3.1GHz~3.5GHz
- 输出功率： 57.5dBm (Typ.)
- 功率增益： 13.5dB (Typ.)
- 功率附加效率： 55% (Typ.)
- 封装形式： 金属封装

产品简介

HX3135P500W 是一种 GaN 内匹配功率管，用于标准的通信频段，在 50 欧姆系统中提供最佳功率和增益性能。

最大额定值 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

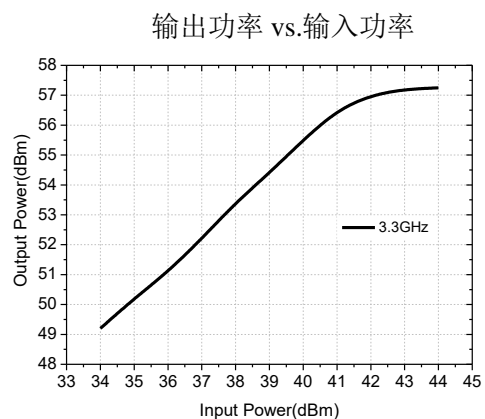
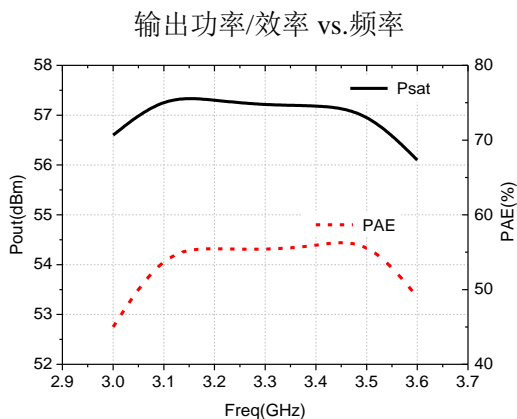
指标	符号	极限值	单位
漏源电压	V_{DS}	60	V
栅源电压	V_{GS}	-5.0	V
存储温度	T_{stg}	-65~+175	$^\circ\text{C}$
沟道温度	T_{ch}	225	$^\circ\text{C}$

电参数 ($T_A = +25^\circ\text{C}$)

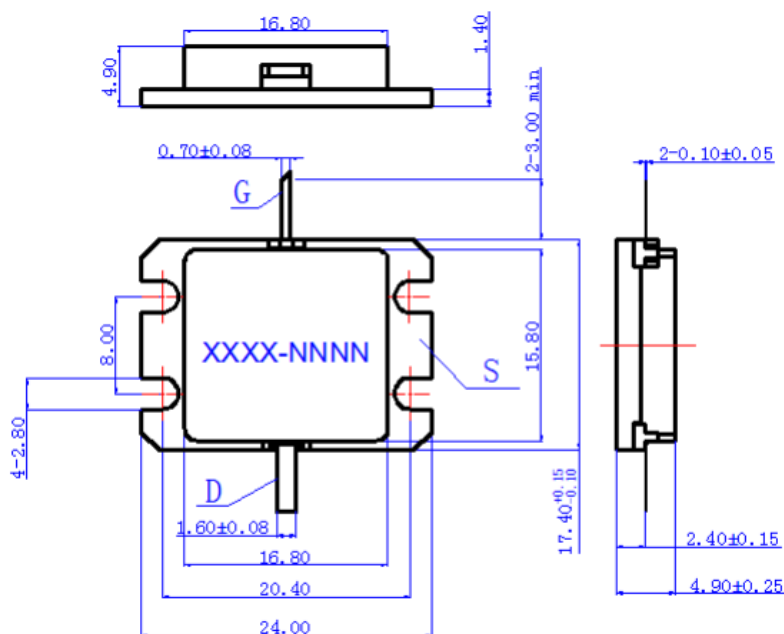
指标	符号	测试条件	极限值			单位
			最小值	典型值	最大值	
夹断电压	V_p	$V_{DS}=3\text{V}, I_{DS} \leq 100\text{mA}$	-1.5	-2.2	-3.0	V
栅极截止电流	I_{GSS}	$V_{DS}=0\text{V}, V_{GS}=-5\text{V}$	—	—	2	mA
饱和输出功率	P_{sat}	$V_{DS}=48\text{V}$ $V_{GS} = -2.4 \sim -3.0\text{V}$, $f=3.1 \sim 3.5\text{GHz}$, 脉宽 100us, 占空比10% $Z_S=Z_L=50\Omega$	57.0	57.5	—	dBm
饱和功率增益	G_{sat}		13.0	13.5*	—	dB
功率附加效率	PAE		50	55	—	%
热阻	$R_{th(j-c)}$	Channel to Case 沟道-管壳	—	0.7	0.85	$^\circ\text{C}/\text{W}$

*功率增益可根据用户使用条件小范围调节。

典型曲线

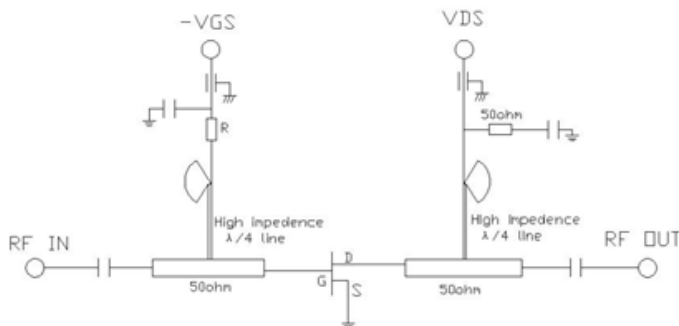


封装尺寸：（单位为 mm）



引出端排列：1-栅极；2-漏极；3-源极

典型使用电路图



注意事项

- 1) 加电时请严格按先加栅压后加漏压的次序操作；
- 2) 使用过程中注意散热，推荐器件工作壳温不超过 75℃，过高会导致器件性能恶化，缩短使用寿命；
- 3) 本产品属于静电敏感器件，储存和使用中注意防静电，仪器、设备等应良好接地；
- 4) 不能触摸器件引线；
- 5) 用图示仪测量直流参数时，必须采取防振荡措施，否则易损坏器件，测试结果也不准确；
- 6) 辐照特性：本器件为辐照不敏感产品；
- 7) 有问题请与供货商联系。



静电敏感性器件
请注意静电防护